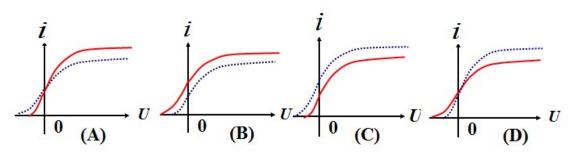
作业四十

- 1. 写出绝对黑体的定义。
- 答:如果某种物质能吸收照射到它上面的所有电磁辐射,则称这种物质为绝对黑体。 物质对电磁辐射的作用有吸收、反射和辐射。绝对黑体只吸收电磁辐射,不反射电磁辐射。但它可以辐射电磁波,而且在不同的温度下,辐射的电磁波的波长(频率)不同。

2.
$$T = \sqrt[4]{\frac{M}{\sigma}} = 827 \text{ K}$$
.

3.



答: [A]

- 理由: (1) 由 $hv = eU_a + A$, 频率增加, 截止电压增加: (A) 或 (C) 正确;
 - (2)由光强 I = Nhv,频率增加光强不变,所以光子数减小,饱和光电流减小。最后选择(A)正确。
- 4. (1) $v_0 = A/h$, $\lambda_0 = hc/A = 296 \text{ nm}$;
 - (2) $\frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 = hv A = 2.0 \text{ eV}$,遏止电压为 $U_a = 2.0 \text{ V}$;
 - (3) $eU_a = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2 = 2.0 \text{ eV}.$

5.
$$\frac{M_2}{M_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}}\right)^4 = \left(\frac{0.9}{0.3}\right)^4 = 81$$
.

- 6. 什么是康普顿效应? 写出康普顿效应散射光的主要特点。
- 答: X 射线照射在散射物质上,在散射光中除了有与入射光相同的波长成分,还有比入射光波长长的成分,这种散射光波长改变的现象,称为康普顿效应。

康普顿效应的主要特点是:康普顿散射光的波长与入射光波长之差 $\Delta \lambda$ 与散射物的性质及入射光波长无关,只与散射角有关。

- 7. $\frac{E_k}{E_0} = \frac{mc^2 m_0c^2}{m_0c^2} = 0.25$,即反冲电子获得的能量是其静止能量的四分之一。
- 8. $hv_{\min} = \frac{hc}{\lambda_{\max}} = \frac{1}{3} m_0 c^2 = 0.17 \text{ MeV }$ (电子静止能量 0.511MeV).

作业四十一

1.
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$$
.

2.
$$U = 150 \text{ V}$$
.

3.
$$d = \frac{2Rh}{ap}$$
.

4.
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{\sqrt{3}}{3} \lambda_0$$
.

5. 热中子应考虑相对论效应:
$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$
和 $E_k = mc^2 - m_0 c^2$, 考虑 $E_k \gg m_0 c^2$, 所以 $E_k = mc^2 - m_0 c^2$, 考虑 $E_k \gg m_0 c^2$, 所以

$$E_k = pc$$
, $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{E_k} = 2.03 \times 10^{-19} \text{ m}.$

6. 不考虑相对论:
$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 0.0409 \text{ nm}$$
.

7.
$$\Delta x \ge \frac{h}{\Delta p} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} = 4 \times 10^5 \text{ nm}.$$

8. 电子。动能相同,静止质量小的动量小,相应的德布罗意波长大。

作业四十二

1. 一维无限深势阱中粒子的能量为
$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = n^2 \times 5.49 \times 10^{-41} \text{ J}$$
.
$$E_{100} = 5.49 \times 10^{-37} \text{ J} = 3.43 \times 10^{-18} \text{ eV}, \quad E_{101} = 5.60 \times 10^{-37} \text{ J} = 3.50 \times 10^{-18} \text{ eV};$$

$$\Delta E = 0.11 \times 10^{-37} \text{ J} = 0.07 \times 10^{-18} \text{ eV}.$$

2. (1)
$$A = \sqrt{2/a}$$
, 归一化的波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ $(0 \le x \le a)$;

(2)
$$\omega_1(x = \frac{a}{4}) = |\psi_1(x)|_{x=a/4}^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}\Big|_{x=a/4} = \frac{1}{a}$$
;

(3)
$$P = \int_{a/3}^{2a/3} |\psi_1(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_{a/3}^{2a/3} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} = 0.61$$

(4)
$$x = \frac{1}{4}a, \frac{3}{4}a$$
处, $P_2 = |\psi_2(x)|^2$ 具有极大值。

3. (1) 角量子数 l = 0,1,2,3,则轨道角动量的可能值为:

$$L = \sqrt{l(l+1)} \ \hbar = 0, \ \sqrt{2} \ \hbar, \ \sqrt{6} \ \hbar, \ 2\sqrt{3} \ \hbar;$$

(2) 磁量子数 $m_i = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$, 角动量在外磁场方向的投影可能值为:

$$L_z=m_l\hbar=0,\pm\hbar,\pm2\hbar,\pm3\hbar\ .$$

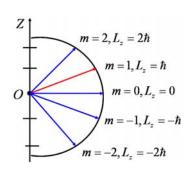
4. (1)
$$L = \sqrt{l(l+1)} \ \hbar = \sqrt{2 \times (2+1)} \ \hbar = \sqrt{6} \ \hbar$$
;

(2) 主量子数为
$$n=4$$
.

- 5. (1) 轨道角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$
 - (2) 磁量子数 m = -2, -1, 0, 1, 2, 轨道角动量在磁场中的分量为

$$L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$$

(3) 由此,可以画出轨道角动量L在磁场空间量子化的示意图

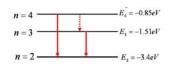


6 解: (1)
$$\psi_{3,1,-1,\frac{1}{2}}$$
 或者 $\psi_{3,2,-1,\frac{1}{2}}$ (2) $\psi_{1,0,0,\frac{1}{2}}$ (3) $\psi_{3,1,1,\frac{1}{2}}$ (4) $\psi_{1,0,0,\frac{1}{2}}$

作业四十三

1.
$$\lambda_{\text{max}} = \frac{4}{3R} = 1.333 \times 10^{-7} \text{ m}$$
; 最小波长满足 $\lambda_{\text{min}} = \frac{1}{R} = 1 \times 10^{-7} \text{ m}$

2. 第 3 激发态: n = 4,跃迁到 n = 2 能级产生的谱线为可见光谱线,有两条。



$$n = 1$$
 $E_1 = -13.6eV$

3. 光子的能量只有刚好等于氢原子某两个能级之差时,光子才能被吸收

$$\Delta E_1 = E_3 - E_2 = -1.51 - (-3.4) = 1.89 \text{ eV}$$

$$\Delta E_2 = E_4 - E_2 = -0.85 - (-3.4) = 2.55 \text{ eV}$$

$$\Delta E_3 = E_5 - E_2 = -0.54 - (-3.4) = 2.86 \text{ eV}$$

所以只有 $\Delta E_1 = E_3 - E_2 = -1.51 - (-3.4) = 1.89$ eV 的光子能够被 n = 2 的能级的氢原子所吸收,氢原子吸收一个光子后,跃迁到 $E_3 = -1.51$ eV (n = 3)的能级上。

4. 由巴尔末公式,知所给波长是从 n=3 向 n=2 能级跃迁得到的。 $\Delta E=E_3-E_1=-1.51-(-13.6)=12.09$ eV.

- 5. 答:在一原子中,不可能有两个或两个以上电子处于相同的状态,即不可能有两个或两个以上电子具有相同的 4 个量子数 (n,l,m_l,m_s) 。
- 6. 答: 泡利不相容原理和能量最小原理。
- 7. 答:有若干不同的电子状态(波函数),处于相同的能级,这就是能级简并。例如,氢原子中,原子处于n能级,但还有 $l=0,1,2,\cdots,n-1$ 个不同的轨道角动量。轨道角动量不同,就是不同的电子状态。原子处于n能级,有n个不同的轨道角动量值,有2l+1个轨道角动量分量,就有 n^2 个不同的电子状态(波函数)。因此,一般说,原子处于n能级,其能级的简并度为 n^2 。

当然,氢原子中电子的状态(波函数),还要有自旋磁量子数 m_e ,能级的简并度更高 $2n^2$ 。

8.
$$\psi_{2,0,0,+\frac{1}{2}}$$
, $\psi_{2,0,0,-\frac{1}{2}}$, $\psi_{2,1,-1,+\frac{1}{2}}$, $\psi_{2,1,-1,-\frac{1}{2}}$, $\psi_{2,1,0,+\frac{1}{2}}$, $\psi_{2,1,0,-\frac{1}{2}}$, $\psi_{2,1,1,+\frac{1}{2}}$, $\psi_{2,1,1,-\frac{1}{2}}$. 可见,氢原子中, $n=2$ 能级是8度简并的。

9. Ar $(z=18) 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, K $(z=19) 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4S^1$.

作业 44

44-1 自发辐射: 无外界刺激, 电子自发地从高能级向低能级跃迁, 发出光;

受激辐射:原子系统在能量密度为 $\rho(v,T)$ 的辐射场中,高能级原子受到光子的刺激跃迁到低能级,同时发射出全同光子。

44-2 自发辐射出的光是非相干光;

受激辐射所产生的光子具有与外来光子完全相同的特性。即它们的频率、相位、振动方向、传播方向均相同(相干光)。

44-3 粒子数反转: 激光器的工作物质处于高能级中的粒子数超过处于低能级的粒子数, 即 $N_2 > N_1$ 。

条件:①要实现粒子数反转,系统要有激励能源使原子激发;②工作物质要有合适的亚稳态能级(至少有三能级以上)。

44-4 (1) $\Delta E = 0.117 \text{ eV}$

(2)
$$\frac{N_1}{N_2} \approx 0.0108$$

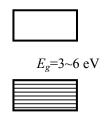
- 44-5 ①让受激辐射延续足够长的距离,实现光放大:
- ②能把传播方向略有偏离的光排除掉,保持激光具有极好的方向性,只有沿轴向的光才能振荡放大:
 - ③选模,使激光的单色性好。
- 44-6 (1) E_3 与 E_4 能级之间实现了粒子数反转
 - (2) 可能产生的激光频率是 $v = (E_4 E_3)/h$
 - (3) 可能产生的荧光光谱有6个。
- 44-7 本征半导体: 纯净而无杂质的半导体。

本征半导体的导电机制: 热激发到空带中的电子和余下的满带中的空穴导电。从价带中激发到导带的电子浓度与价带中的空穴浓度相等,即导电的电子和空穴都是主要载流子。

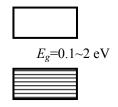
44-8 (1) 导体:满带和空带之间无禁带,价带是不满的,在外电场的作用下,这种不满的能带中的电子就起导电作用。如图 (a)表示单价金属晶体(如 Li)一类的能级结构,其价带未填满电子,是导带。图 (b)表示二价金属(如 Be, Mg 等)一类的能级结构,其满带与空带部分重叠,形成一个导带。图 (c)表示另一类金属晶体(如 Na, K, Cu 等)的能级结构,其价带本来就未被电子填满,而这个价带又与空带重叠。



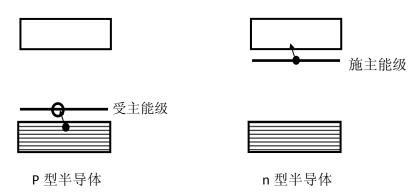
(2) 绝缘体: 满带和空带之间的禁带很宽, 满带中的电子很难从低能级(满带) 跃迁到高能级(空带)上。价带是满带,价带与空带之间有一较宽的禁带 ($E_{\sigma}=3\sim6\,\mathrm{eV}$)。



(3) 半导体: 满带和空带之间有禁带,但禁带较窄($E_g = 0.1 \sim 2 \, \text{eV}$),热激发很容易使电子从低能级(满带)跃迁到高能级(空带)上。



44-9



- (1) p型半导体杂质能级的特点:在满带上方邻近处有杂质能级(受主能级),提供空穴,使得满带中的电子较容易激发到该受主能级上,从而在满带中形成空穴,产生空穴导电:
- (2) n 型半导体杂质能级的特点:在空带下方邻近处有杂质能级(施主能级),提供电子,使得杂质能级中的电子较容易激发到空带上,从而在空带中形成电子,产生电子导电:
- (3)对于本征半导体,它的导电特征是参加导电的正、负载流子的数目相等,总电流是电子流和空穴流的代数和。至于杂质半导体,n型半导体主要导电的载流子是电子,P型半导体主要导电的载流子是空穴。这两种类型都是由杂质原子起主要导电作用,由于杂质半导体中的电子跃迁到导带中去(n型半导体),或满带中的电子跃迁到杂质能级中来(p型半导体),都较本征半导体满带中的电子直接跃迁到导带中来得容易,所以少量的杂质就会显著地影响导带中的电子数或满带中的空穴数。因而少量杂质将会显著地影响半导体的导电性。

44-10 (1)
$$\lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{\Delta E} = 1035.9 \text{nm}$$

(2)
$$\lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{\Delta E} = 27608 \text{nm}$$